

тическими значениями ширины запрещенных зон E_g полупроводников ZnSe и CdTe. Связанные электронные состояния с симметрией a_1 в ZnSe и CdTe дают только анионные вакансии, но с симметрией t_2 — как анионные, так и катионные вакансии.

Приведенное в таблице значение энергии резонансного a_1 -состояния катионной вакансии в CdTe согласуется с данными работы [6] для неискаженной нейтральной вакансии. Такая идеальная вакансия описывается моделью удаления на электронные уровни вакансий в полупроводнике удобно изучать с помощью (3), используя в качестве эффективной среды полупроводник с идеальной вакансией.

Л и т е р а т у р а

- [1] Тележкин В. А., Толпыго К. Б. Теория электронной структуры радиационных дефектов в полупроводниках. — ФТП, 1982, т. 16, в. 6, с. 1337—1364.
- [2] Баженов В. К., Гардашев Д. Л., Нахабин А. В. Электронные уровни нейтральных вакансий в A_3B_5V полупроводниках. — ФТП, 1986, т. 20, в. 1, с. 113—117.
- [3] Смирнов В. П., Эварестов Р. А. Локализованные орбитали в кристаллах и зонные представления пространственных групп. — ФТТ, 1983, т. 25, в. 11, с. 3261—3267.
- [4] Нахабин А. В. Локализованные орбитали в кристаллах с ковалентными связями. — Автореф. канд. дис. Одесса, 1984.
- [5] Chelikowsky J. R., Cohen M. L. — Phys. Rev. B, 1976, v. 14, N 2, p. 556—582.
- [6] Chen A. B., Sher A. — Phys. Rev. B, 1985, v. 31, N 10, p. 6490—6497.

Одесский институт инженеров
морского флота

Получено 25.11.1986
Принято к печати 21.07.1987

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

XI ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Кишинев, октябрь, 1988 г.

Научный совет по проблеме «Физика и химия полупроводников» АН СССР, Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе АН СССР, Институт прикладной физики АН МССР и Министерство высшего и среднего специального образования МССР проводят в октябре 1988 г. в г. Кишиневе XI Всесоюзную конференцию по физике полупроводников.

Эта конференция является основной в нашей стране конференцией по физике полупроводников, регулярно проводимой один раз в три года. Организатором и основоположником первых конференций этого рода был академик А. Ф. Иоффе.

В программу XI конференции предполагается включение 25—30 приглашенных докладов по наиболее актуальным проблемам физики полупроводников, 80—100 оригинальных сообщений для зачитания и 150—180 стендовых докладов. Особое внимание будет обращено на следующие направления:

- 1) физические явления в гетероструктурах и сверхрешетках;
- 2) физические процессы в структурах с пониженной размерностью;
- 3) электронные и атомные процессы на границах раздела;
- 4) влияние разупорядоченности на электронные процессы в полупроводниках;
- 5) электронные явления в сильных электрических и магнитных полях;
- 6) физические явления в магнитных и полумагнитных полупроводниках;
- 7) фемто- и пикосекундная спектроскопия полупроводников;
- 8) современная диагностика полупроводниковых структур.

Направления, по которым проводятся в 1988 г. специализированные конференции, будут представлены только докладами по приглашению.

В программу данной конференции будут включаться оригинальные сообщения, которые содержат не опубликованные и не докладывавшиеся ранее результаты.

Срок представления тезисов докладов до 15 мая 1988 г.

Правила оформления и другие подробности будут указаны во втором информационном сообщении.

Оргкомитет
Программный комитет